

Влияние магнитных полей более удивительно. Укажем только на работу [10], в которой также наблюдаются необычные влияния магнитных полей — образование магнитоэлектретов в ПЭ, изменение структуры и др.

Список литературы

- [1] Гуль В. Е., Царский Л. Н., Майзель Н. С., Шенфиль Л. З., Журавлев В. С., Шибря Н. Г. Электро проводящие полимерные материалы. М.: Химия, 1968. 248 с.
- [2] Василенок Ю. И. Предупреждение статической электризации полимеров. Л.: Химия, 1981. 208 с.
- [3] Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 1979. 416 с.
- [4] Лесото А. П., Усиченко В. М., Будницкий Ю. С., Акутин М. С., Пономаренко А. Т., Овчинников А. А. // ДАН СССР. 1984. Т. 274. № 6. С. 1410—1413.
- [5] Дорофеева Т. В., Шклярова Е. И., Галашина Н. М., Григоров Л. Н., Ениколопян Н. С. // ДАН СССР. 1984. Т. 276. № 5. С. 1155—1159.
- [6] Ландау Л., Лифшиц Е. И. Статистическая физика. М.: Наука, 1976. 584 с.
- [7] Кестельман В. Н. Физические методы модификации полимерных материалов. М.: Химия, 1980. 233 с.
- [8] Белый В. А., Снежко В. В., Батаев Ю. В., Воронежцев Ю. И., Гольдаде В. А., Пинчук Л. С. // ДАН СССР. 1986. Т. 290. № 2. С. 373—375.
- [9] Харитонов Е. В. Диэлектрические материалы с неоднородной структурой. М.: Радио и связь, 1983. 126 с.
- [10] Манько Т. А., Кваша А. Н., Соловьев А. В., Щенева В. Б., Еромолаев И. М. // Механика композиционных материалов. 1984. № 4. С. 589—590.

Ленинградский
государственный университет
Ленинград

Поступило в Редакцию
29 августа 1988 г.
В окончательной редакции
13 января 1989 г.

УДК 539.219

Физика твердого тела, том 31, в. 8, 1989

Solid State Physics, vol. 31, № 8, 1989

РАСЧЕТ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛА $ZnGeP_2$

B. Г. Тютерев

Полупроводниковое соединение $ZnGeP_2$ является перспективным соединением для нелинейной оптики в инфракрасном диапазоне. ИК оптические свойства определяются структурой колебательного спектра, что обуславливает интерес к теоретическому изучению фононного спектра, плотности колебательных состояний и других решеточных характеристик.

Экспериментальные исследования оптических свойств $ZnGeP_2$ в решеточной области частот к настоящему времени представлены работами [1—3]. Решеточный вклад в теплоемкость экспериментально изучался в [4].

Кристалл $ZnGeP_2$ относится к семейству халькопиритов (8 частиц в элементарной ячейке, группа симметрии D_{2d}^{12}). Классификация фононного спектра по симметрии проведена в [5]. Теоретическая модель фононных спектров халькопиритов $A''B''C_2$ развита в [6—8]. В рамках феноменологической модели жестких ионов [6] межатомное взаимодействие описывается двумя матрицами силовых констант для неэквивалентных связей ближайших соседей. В пренебрежении малыми поправками на тетрагональное сжатие и смещение анионов из идеальных позиций

$$\Phi_{ZnP} = \begin{pmatrix} \Delta - y + 2z & x - y & x - y + z \\ x - y & \Delta - y & x - y - z \\ x - y + z & x - y - z & \Delta - y + z \end{pmatrix}, \quad \Phi_{GeP} =$$

$$= \begin{pmatrix} \Delta + y - 2z & x + y & x + y - z \\ x + y & \Delta + y & x + y + z \\ x + y - z & y + x + z & \Delta + y - z \end{pmatrix}.$$

Четыре параметра короткодействующих сил (10^3 дин/см) $\Delta = -47.88$, $x = -39.92$, $y = -5.85$, $z = 3.23$ и эффективные заряды ионов (а. е.) $e_{Zn}^* = 0.94$, $e_{Ge}^* = 0.40$, $e_P^* = -0.67$ определены исходя из значений частот, из-

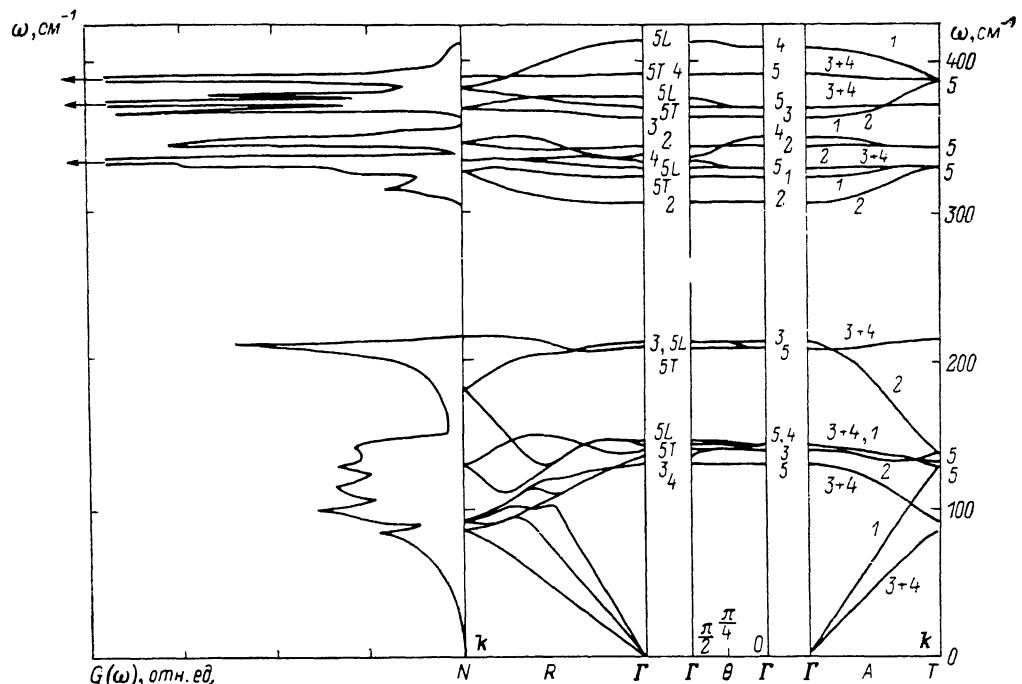


Рис. 1. Фононный спектр и плотность состояний кристалла ZnGeP₂.

меренных в ИК поглощении и КР света [1-3]. Процедура подгонки описана в [6]. О качестве подгонки можно судить по данным таблицы.

Вычисленные и экспериментально измеренные значения частот длинноволновых фононов ω_{LO}/ω_{TO} (см⁻¹) в ZnGeP₂

Симметрия фотона [5]	Эксперимент			Теория
	[1]	[2]	[3]	
Γ_5	402/385	406/386	405/387	414/391
	375/370	375/369	377/369	375/370
	332/330	—	330/328	334/329
	204/202	203/203	206/204	212/208
	—	141/141	144/143	145/142
	80/80	94/94	—/96	130/130
Γ_4	401/392	—/396	411/401	411/391
	360/348	—/343	361/341	350/337
Γ_3	—	—	—	143/138
	—	389	—	364
	—	247	249	211
Γ_1	—	120	121	141
	—	328	329	324

Плотность колебательных состояний

$$G(\omega) = \sum_{\lambda} \int \delta(\omega - \omega_{\lambda}(k)) d^3 k \Omega_{\lambda} / (2\pi)^3 3s$$

(Ω_{λ} — объем элементарной ячейки; $\omega_{\lambda}(k)$ — частота фонона ветви $\lambda = 1, \dots, 24$; k — волновой вектор; s — число частиц в элементарной ячейке) рассчитывалась методом тетраэдров (384 тетраэдра в неприводимой части зоны Бриллюэна, спектр вычислялся в сетке из 125 точек).

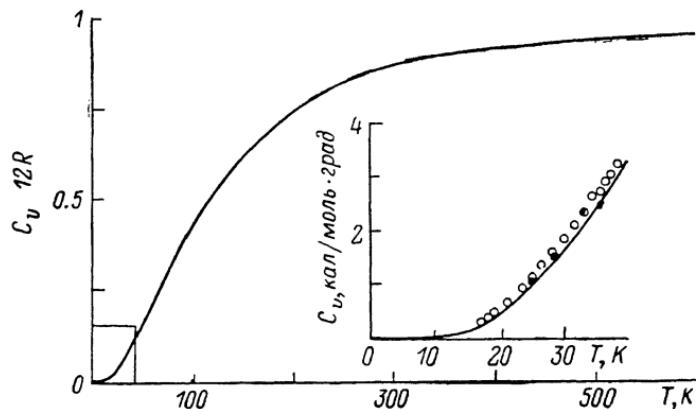


Рис. 2. Удельная теплоемкость $ZnGeP_2$.

Рассчитанный колебательный спектр $ZnGeP_2$ в двух симметричных направлениях A ($0 0 \mu/c$), R ($\mu/a \mu/a 0$), $\mu \leq \pi$, а также $G(\omega)$ приведены на рис. 1. Особенностью фононных спектров халькопиритов является наличие зависимости частот длинноволновых ($k \rightarrow 0$) фононов от угла θ между тетрагональной осью с кристалла и вектором k . В центре рис. 1 представлена эта зависимость ($\Gamma-\Gamma$). В нашем расчете $G(\omega)$ угловая

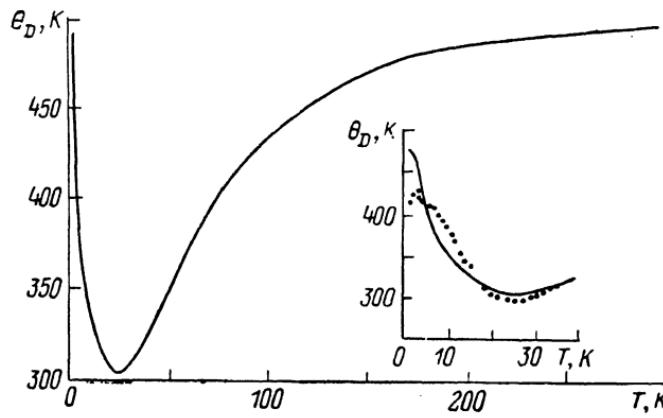


Рис. 3. Температура Дебая $ZnGeP_2$.

дисперсия учитывалась приближенно, в точке Γ ($0 0 0$) в качестве $\omega_{\lambda}(0 0 0)$ принималось значение $\lim_{k \rightarrow 0} (\omega_{\lambda}(k 0 0) + \omega_{\lambda}(0 k 0) + \omega_{\lambda}(0 0 k)) / 3$. Сходимость метода тетраэдров может характеризоваться степенью выполнения правила сумм $\int G(\omega) d\omega = 1$, отклонение от которого в наших расчетах составляет менее 3 %. Расчеты $G(\omega)$ для кристаллов со структурой халькопирита проведены в работах [8, 9] развитым в [9] обобщенным методом спецточек. Наши расчеты $G(\omega)$ для $ZnGeP_2$ в целом согласуются с результатами [8, 9]; различия в основном касаются тонких деталей структуры плотности состояний в высокочастотной области. Заметим, что метод, развитый в [9], обладает плохой сходимостью для акустической части спектра, что не

позволяет правильно воспроизвести дебаевский участок спектра $G(\omega) \sim \omega^2$.

На рис. 2, 3 приведены удельная теплоемкость $C_v(T)$ и характеристическая температура $\Theta_b(T)$ для $ZnGeP_2$, рассчитанные без учета поправок на ангармонизм, а также экспериментальные данные [4]. Видно хорошее согласие расчета и эксперимента.

Список литературы

- [1] Miller A., Holah G. D., Clark W. C. // J. Phys. Chem. Sol. 1974. V. 35. N 6. P. 685—693.
- [2] Bettini M., Miller A. // Phys. St. Sol. 1974. V. B66. P. 579—586.
- [3] Григорьев В. С., Марков Ю. Ф., Рыбакова Т. Ф. // ФТТ. 1975. Т. 17. № 7. С. 1993—1995.
- [4] Abrahams S. C., Hsu F. S. L. // J. Chem. Phys. 1975. V. 63. N 3. P. 1162—1165.
- [5] Караваев Г. Ф., Поплавной А. С., Тюттерев В. Г. // Изв. вузов, физика. 1970. № 10. С. 42—48.
- [6] Поплавной А. С., Тюттерев В. Г. // ФТТ. 1975. Т. 17. № 3. С. 1055—1060.
- [7] Poplavnoi A. S., Tuyuterev V. G. // J. de Physique. 1975. Coll. C. 3. Suppl. N 9. V. 36. P. C3—169—C3—176.
- [8] Поплавной А. С. // Изв. вузов, физика. 1986. № 8. С. 5—18.
- [9] Копытов А. В., Золотарев М. Л., Поплавной А. С. // Деп. в ВИНИТИ. 1985. № 209-85.

Томский государственный университет
ФТИ
Томск

Поступило в Редакцию
16 января 1989 г.

УДК 669.863

Физика твердого тела, том 31, в. 8, 1989
Solid State Physics, vol. 31, N 8, 1989

МАГНИТОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ ТЕРБИЯ И ДИСПРОЗИЯ

Г. И. Катаев, С. В. Редько,
М. Р. Саттаров, А. М. Тишин

Интерес к исследованию геликоидальных антиферромагнитных структур (АФМ), наблюдавшихся в тяжелых редкоземельных металлах (РЗМ), в настоящее время в значительной степени связан с необходимостью детального изучения воздействия на эти структуры магнитных полей, приложенных вдоль разных кристаллографических направлений. Известно [1], что приложение магнитного поля в базисной плоскости вызывает в Tb и Dy в области существования АФМ структуры магнитный фазовый переход в ферромагнитное состояние (ФМ). Теоретически и экспериментально [2, 3] показана возможность существования в данном случае промежуточного между АФМ и ФМ веерного магнитного упорядочения.

В [4—7] обсуждается также возможность существования в окрестности температуры Θ_2 (точки магнитного фазового перехода парамагнетизм (ПМ)—АФМ) вихревой магнитной структуры. В [4] показано, что равновесное состояние легкоплоскостного ферромагнетика неустойчиво относительно образования вихревой структуры, если ось образца перпендикулярна базисной плоскости. На основании нейтронографических исследований Dy вблизи Θ_2 в [5] предполагается, что при охлаждении из ПМ в АФМ состояние сначала возникает вихревая структура, существующая в диапазоне 173.7—178.5 К, которая затем при $T < 173.7$ К переходит в АФМ фазу. Вместе с тем было установлено [5], что при нагреве образца вихревая структура не возникает. Однако поиск вихревой структуры в Dy